


	<p>SI4910DY-T1-GE3</p> <p>Hersteller-Teilenummer: SI4910DY-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2N-CH 40V 7.6A 8-SOIC</p> <p>Datenblätter:  SI4910DY-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	







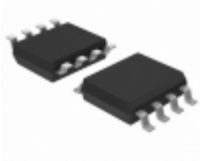
Spezifikationen

Teilenummer	SI4910DY-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 40V 7.6A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	27 mOhm @ 6A, 10V
Leistung - max	3.1W
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Andere Namen	SI4910DY-T1-GE3DKR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	855pF @ 20V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	32nC @ 10V
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Standard
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) 40V 7.6A 3.1W Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	7.6A
Basisteilenummer	SI4910

SI4910DY-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI4910DY-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI4910DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI4910DY-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI4913DY SI SI4913DY SI</p>	 <p>SI4913DY-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 20V 7.1A 8-SOIC</p>	 <p>SI4909DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 40V 8A 8SO</p>	 <p>SI4910DY VIS SI4910DY VIS</p>
 <p>SI4911DY-T1-E3 VISHAY SI4911DY-T1-E3 VISHAY</p>	 <p>SI4910DY-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 40V 7.6A 8-SOIC</p>	 <p>SI4911DY-T1-E3, VISHAY SI4911DY-T1-E3, VISHAY</p>	 <p>SI4910DY-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 40V 7.6A 8-SOIC</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SI4910DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SI4910DY-T1-GE3 Datenblatt	SI4910DY-T1-GE3-Datenblätter	SI4910DY-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI4910DY-T1-GE3
SI4910DY-T1-GE3 Electronic	SI4910DY-T1-GE3-Komponenten	SI4910DY-T1-GE3-Verteiler	SI4910DY-T1-GE3-Bild	SI4910DY-T1-GE3-Teil
SI4910DY-T1-GE3 Preis	SI4910DY-T1-GE3 Hersteller	SI4910DY-T1-GE3 Bild	SI4910DY-T1-GE3 Aktie	SI4910DY-T1-GE3 Inventar
SI4910DY-T1-GE3 Neu	SI4910DY-T1-GE3 Original	SI4910DY-T1-GE3 garantiert	SI4910DY-T1-GE3 RFQ	SI4910DY-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited